

# Photodiode JE 4,8-R



- Charakteristik :**
- ◆ integriertes Rotfilter
  - ◆ strahlungsempfindliche Fläche (2,2x2,2) 4,8 mm<sup>2</sup>
  - ◆ hochwertige Si - PIN - Photodiode mit niedrigem Dunkelstromniveau, hohem Nullpunkt-widerstand
  - ◆ hermetisches TO39 - Gehäuse

- Applikationen :**
- ◆ Detektor für lichttechnische Anwendungen
  - ◆ Farbmestechnik

**Grenzwerte:**

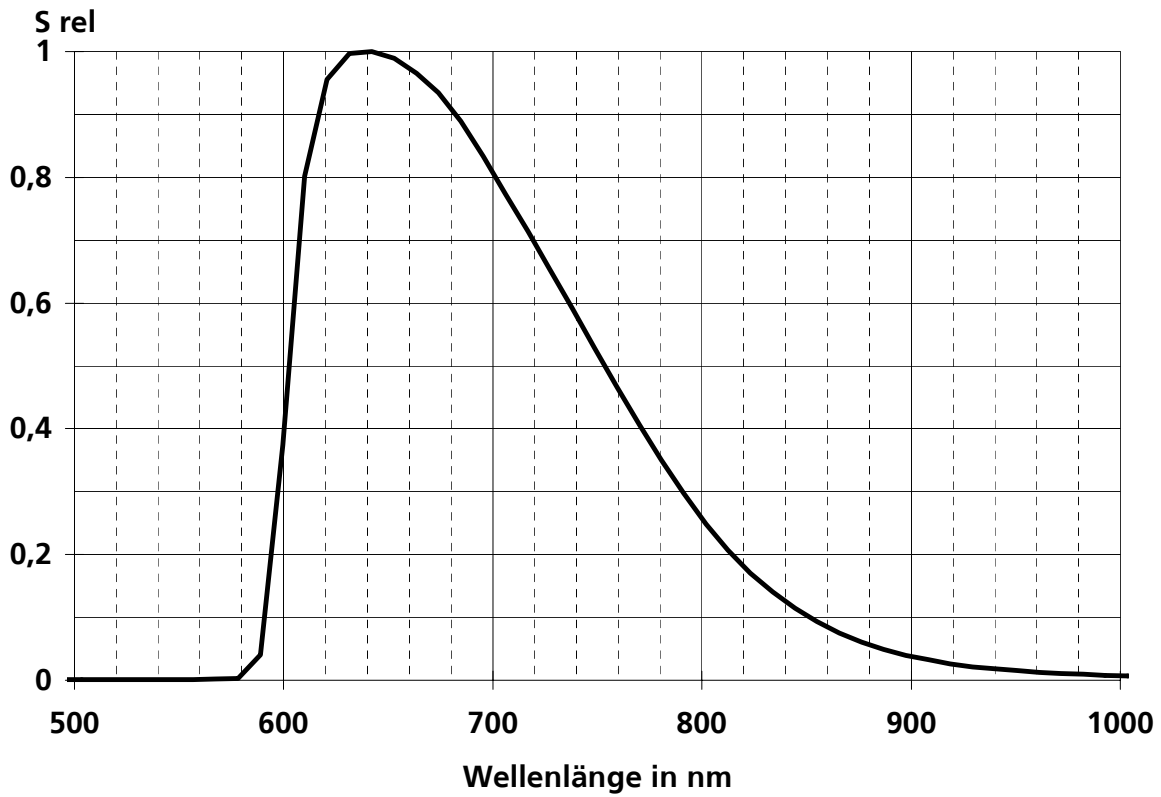
|                           |                |    |
|---------------------------|----------------|----|
| Sperrspannung             | 20             | V  |
| Betriebstemperaturbereich | - 25 °C ... 70 | °C |
| Lagertemperaturbereich    | 0 °C ... 100   | °C |
| Löttemperatur (3s)        | 260            | °C |

**Technische Daten :**

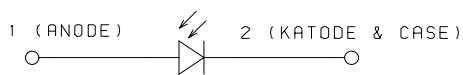
Allgemeine Meßbedingungen, sofern nicht anders spezifiziert:  $\gamma_a = 25 \text{ °C}$ ,  $V_R = 0V$

| Parameter   | Meßbedingung   | min. | typ.    | max. | Einh.           |
|---|--|------|---------|------|-----------------|
| strahlungsempfindliche Fläche                     |  |      | 4,8     |      | mm <sup>2</sup> |
| Max. der spektralen Empfindlichkeit $S_{max}$ bei |  |      | 640     |      | nm              |
| Halbwertsbreit                                    | $S = 0,5 \cdot S_{max}$  |      | 150     |      | nm              |
| absolute spektrale Empfindlichkeit                | $\lambda = 640 \text{ nm}$   |      | 0,33    |      | A/W             |
| Dunkelstrom $I_R$                                 | $V_R = 10 \text{ V}, E = 0 \text{ lx}$   |      | 2       | 20   | nA              |
| Anstiegszeit<br>Abfallzeit<br>des Fotostromes     | $R_L = 1 \text{ k}\Omega$<br>$\lambda = 830 \text{ nm}$<br>$V_R = 5 \text{ V}$<br>$I_F = 20 \mu\text{A}$ |      | 150     |      | ns              |
| Kapazität   | $f = 1 \text{ Mhz}$<br>$E = 0 \text{ lx}, V_R = 0V$<br>$E = 0 \text{ lx}, V_R = 20V$                     |      | 50<br>8 |      | pF              |

## relative spektrale Empfindlichkeit



## Anschlußbelegung



## Gehäuseabmessungen,

